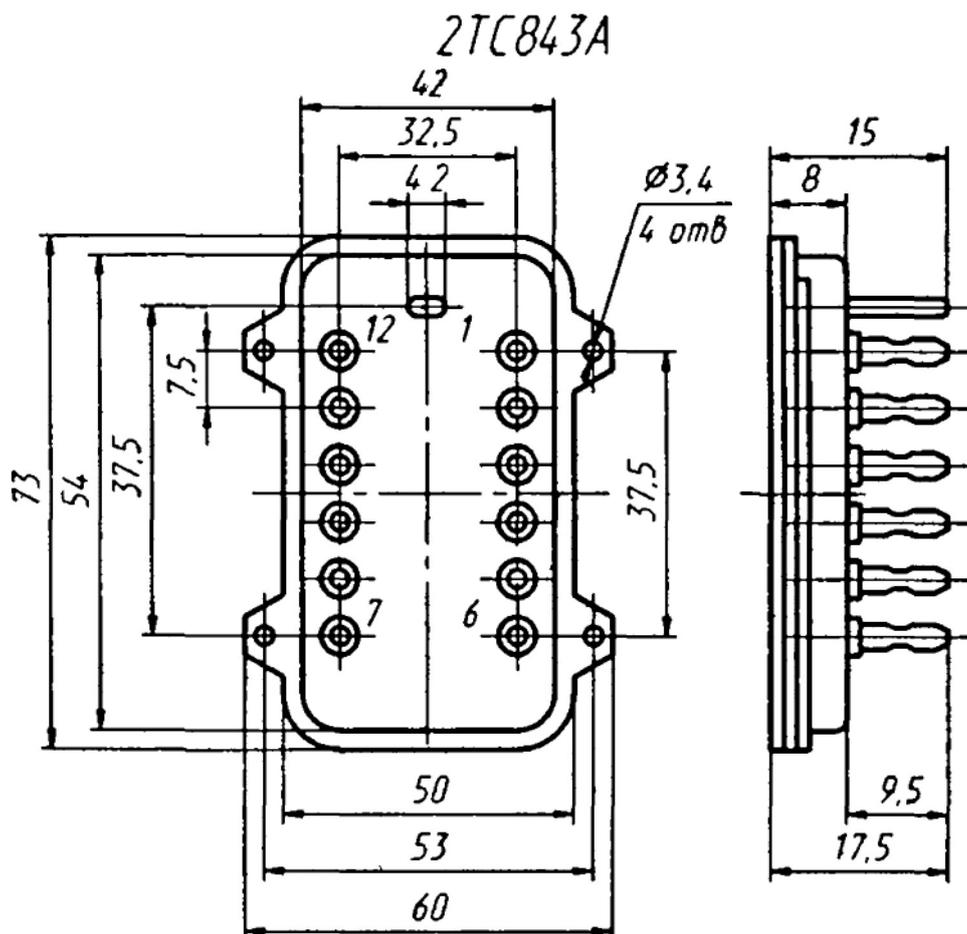


2ТС843А

Транзисторная сборка, состоящая из четырех переключающих кремниевых мезапланарных структур $n-p-n$ транзисторов. Предназначена для применения в источниках вторичного электропитания в системах автоматического управления. Корпус металлический с жесткими выводами.

Масса сборки не более 13 г.



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кб} = 0$, $I_k = 12$ А, для 1-го и 2-го транзисторов, $I_k = 3$ А для 3-го и 4-го транзисторов:

$T = +25$ °С	10...50
$T = +125$ °С	10...150
$T = -60$ °С	6...50*

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер, не более:

1-го транзистора при $I_k = 12$ А, $I_b = 2,4$ А	0,6 В
2-го транзистора при $I_k = 12$ А, $I_b = 2,4$ А	0,6 В
3-го транзистора при $I_k = 3$ А, $I_b = 0,6$ А ..	0,6 В

4-го транзистора при $I_K = 3 \text{ А}$, $I_B = 0,6 \text{ А}$..	0,6 В
Напряжение насыщения база—эмиттер, не более:	
1-го транзистора при $I_K = 12 \text{ А}$, $I_B = 2,4 \text{ А}$.	1,5 В
2-го транзистора при $I_K = 12 \text{ А}$, $I_B = 2,4 \text{ А}$.	1,5 В
3-го транзистора при $I_K = 3 \text{ А}$, $I_B = 0,6 \text{ А}$..	1,5 В
4-го транзистора при $I_K = 3 \text{ А}$, $I_B = 0,6 \text{ А}$..	1,5 В
Время включения, не более	1 мкс
Время спада, не более	0,7* мкс
Время рассасывания, не более	2 мкс
Обратный ток коллектор—эмиттер, не более:	
при $T_K = -60...+25 \text{ }^\circ\text{C}$:	
1-го и 2-го транзисторов при $U_{KЭ} = 120 \text{ В}$, $R_{БЭ} = 2,5 \text{ Ом}$	12 мА
3-го и 4-го транзисторов при $U_{KЭ} = 120 \text{ В}$, $R_{БЭ} = 10 \text{ Ом}$	3 мА
при $T_K = +125 \text{ }^\circ\text{C}$:	
1-го и 2-го транзисторов при $U_{KЭ} = 120 \text{ В}$, $R_{БЭ} = 2,5 \text{ Ом}$	80 мА
3-го и 4-го транзисторов при $U_{KЭ} = 120 \text{ В}$, $R_{БЭ} = 10 \text{ Ом}$	20 мА
Обратный ток эмиттер при $U_{БЭ} = 4 \text{ В}$:	
1-го и 2-го транзисторов	0,2 мА
3-го и 4-го транзисторов	0,05 мА

Предельные эксплуатационные данные

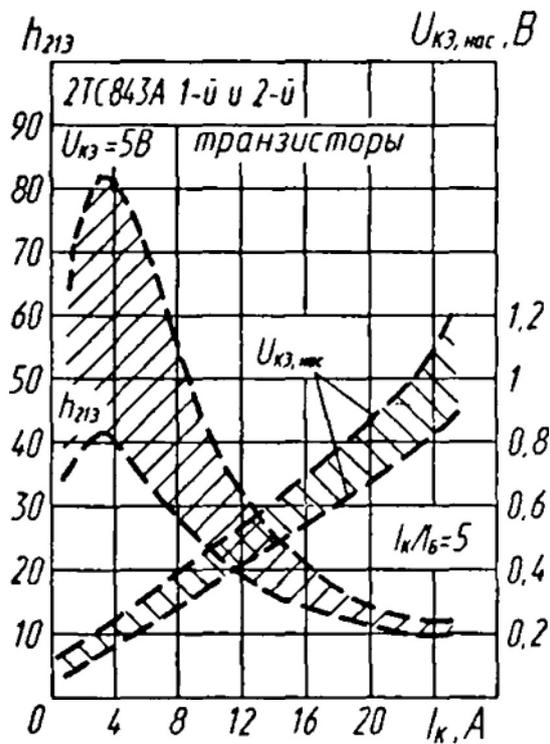
Постоянное и импульсное напряжение кол- лектор—эмиттер ¹ при $R_{БЭ} = 2,5 \text{ Ом}$ для 1-го и 2-го транзисторов; $R_{БЭ} = 10 \text{ Ом}$ для 3-го и 4-го транзисторов, $T_K = -60...+100 \text{ }^\circ\text{C}$	120 В
Постоянное напряжение база—эмиттер	4 В
Постоянный ток коллектора:	
1-го и 2-го транзисторов	12 А
3-го и 4-го транзисторов	3 А
Сумма постоянных токов коллекторов транзи- сторов при их одновременном включении	30 А
Импульсный ток коллектора при $t_{и} = 10 \text{ мкс}$, $Q \geq 5$:	
1-го и 2-го транзисторов	25 А
3-го и 4-го транзисторов	6 А
Сумма импульсных токов коллекторов транзи- сторов при их одновременном включении	62 А
Постоянный ток базы:	
1-го и 2-го транзисторов	8 А
3-го и 4-го транзисторов	2 А

Сумма постоянных токов баз транзисторов при их одновременном включении	20 А
Постоянная рассеиваемая мощность:	
при $T_K = -60...+100$ °С:	
1-го и 2-го транзисторов	10 Вт
3-го и 4-го транзисторов	2,5 Вт

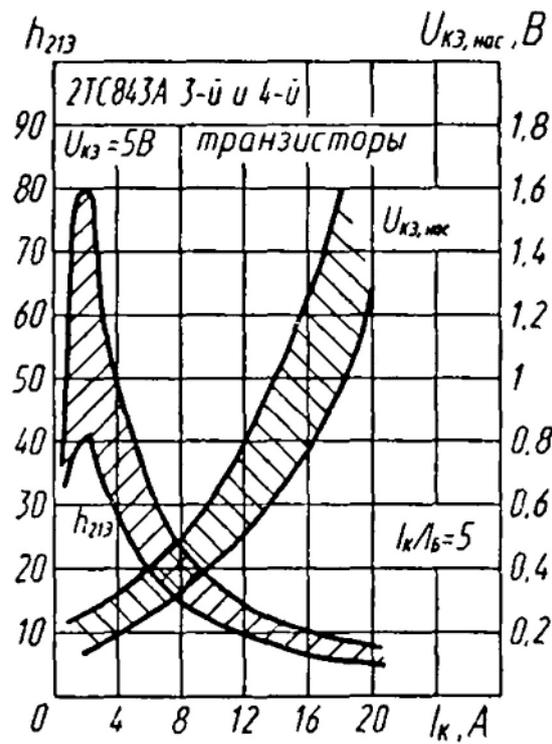
При $T_K = +100...+125$ °С $U_{КЭ R, МАКС}$, $U_{КЭ R, И, МАКС}$ снижаются на 10% на каждые 10 °С.

сумма постоянных рассеиваемых мощностей транзисторов при их одновременном включении	25 Вт
при $T_K = +100...+125$ °С:	
1-го и 2-го транзисторов	8 Вт
3-го и 4-го транзисторов	2 Вт
сумма постоянных рассеиваемых мощностей транзисторов при их одновременном включении	20 Вт
Импульсная рассеиваемая мощность при $t_{и} = 10$ мкс:	
1-го и 2-го транзисторов	1600 Вт
3-го и 4-го транзисторов	400 Вт
Сумма импульсных рассеиваемых мощностей транзисторов при их одновременном включении	4000 Вт
Температура окружающей среды	$-60...T_K = +125$ °С

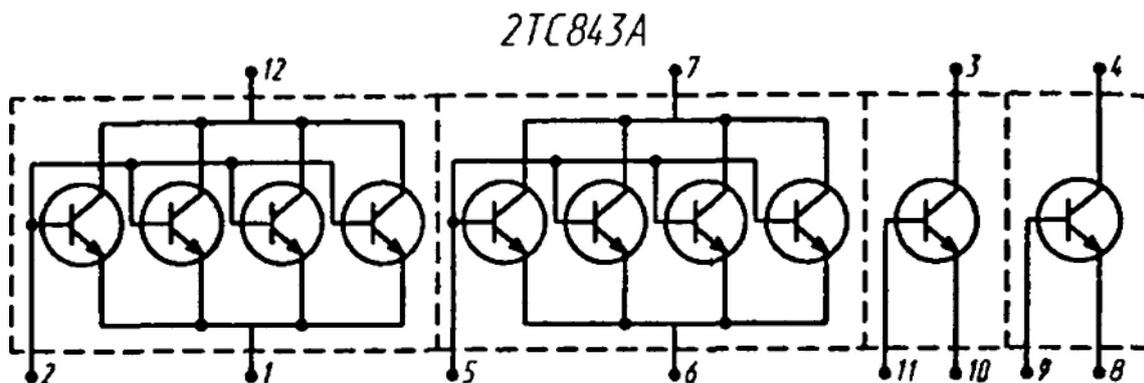
Пайка транзисторов допускается при температуре +250 °С в течение не более 5 с. Не допускается обрезка, формовка и изгиб выводов.



Зоны возможных положений зависимостей статического коэффициента передачи тока и напряжения насыщения коллектор—эмиттер от тока коллектора



Зоны возможных положений зависимостей статического коэффициента передачи тока и напряжения насыщения коллектор—эмиттер от тока коллектора



Электрическая схема сборки и схема соединения электродов с наружными выводами